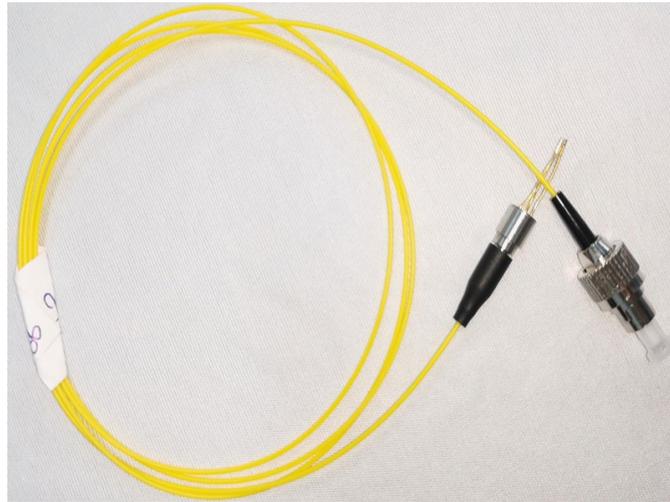


InGaAs盖革模式雪崩光电二极管(非制冷型)



产品描述:

InGaAs 雪崩光电二极管 (APD) 是短波近红外单光子检测的专用器件, 可满足量子通信、弱光探测等领域对高效率低噪声单光子检测的技术需求, 实现对0.9 ~ 1.7 μm 波长的单光子探测。

产品特点:

- 光谱响应范围0.9~1.7 μm
- 高探测效率、低暗计数率
- 3 pin TO46

产品应用:

- 弱光探测
- 量子保密通信
- 生物医疗

技术参数:

线性模式参数

产品型号				IGA-APD-GM104-R		
参数	符号	单位	测试条件	最小	典型	最大
反向击穿电压	VBR	V	22°C±3°C, ID=10μA	60	80	90
响应度	Re	A/W	22°C±3°C, λ=1550nm, M=1	0.8	0.85	
暗电流	ID	nA	22°C±3°C, M=10		0.1	0.3
电容	C	pF	22°C±3°C, M=10, f=1MHz			0.25
击穿电压温度系数	η	V/K	-40°C~80°C, ID=10μA			0.15

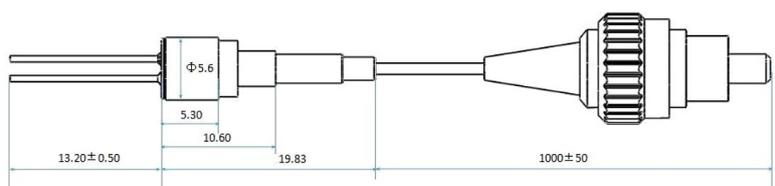
盖革模式参数

参数	单位	测试条件	最小	典型	最大
单光子探测效率PDE	%	-45°C, λ=1550nm, 0.1ph/pulse 泊松分布单光子源	20	-	
暗计数率DCR	kHz	-45°C, 1ns门宽, 2MHz门控重频, 1MHz光重频, PDE=20%	-	-	20*
后脉冲概率APP		-45°C, 1ns门宽, 2MHz门控重频, 1MHz光重频, PDE=20%	-	-	1×10 ⁻³
时间抖动Tj	ps	-45°C, 1ns门宽, 2MHz门控重频, PDE=20%	-	-	100

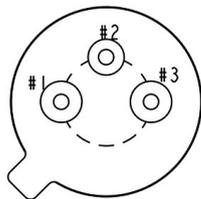
* 可提供不同等级规格产品

尺寸规格:

TO46 (尾纤封装)



单位: mm



PIN#	定义
1	P (阳极)
2	壳接地
3	N (阴极)